THERMAL TYPE INFRARED RAY DETECTING DEVICE

Publication number: JP9257584 Publication date: 1997-10-03

Inventer: HIROTA MASAKI
Applicant: NISSAN MOTOR

Classification:

al: G01J5/12; G01J5/14; G01J5/12; (IPC1-7): G01J5/12

- European:

Application number: JP19960071924 19960327

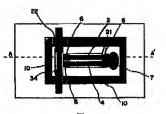
Priority number(s): JP19960071924 19960327

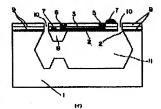
Report a data error here

Abstract of JP9257584

PROBLEM TO BE SOLVED: To reconcile sensitivity and response speed by controlling so that a temperature of cold contact points becomes equal to a temperature of a hot contact point on the basis of thermoelectromotive force generated from a temperature difference between a temperature of a cold contact points an a temperature of the hot contact point whose temperature rises by absorption of incident infrared rays. SOLUTION: A thermopile 21 composed of (p) type and (n) type polysilicon 3 and 4 and an Al thin film is arranged on a base board 1. In a connecting area of the polysilicon 3 and 4 and the Al thin film, its one end becomes a hot contact point 5, and the other end becomes cold contact points 6. A Joule heat source 34 is arranged in the vicinity of the coli contact points 6, and an infrared ray absorbing area 7 is formed in the vicinity of the hot contact point 5. incident infrared rays are absorbed by the infrared ray absorbing area 7, and raise a temperature of the absorbing area 7, and also aise a temperature of the hot contact point 5. An electric potential difference between the two cold contact points 6 and 6 generated by a temperature difference between the hot contact point 5 and the cold contact points 6, is sent to a cold contact point temperature control means 22, and heats the cold contact points 6 by heat generate by the Joule heat source 34. This operation is continued until a temeprature difference between the hot and cold contact points 5 and 6 is elimated, and is also performed at high speed since the

thermopile 21 is heated from both sides.





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出版公開番号 特開平9-257584

(43)公開日 平成9年(1997)10月3日

(51) Int.Cl.* G01J 5/12 裁別紀号 庁内整理番号

FI G01J 5/12 技術表示信所

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)

(21)出版番号 特膜平8-71924

(22)出順日

平成8年(1996)3月27日

(71)出版人 000003997

日直自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

(72)発明者 廣田 正樹

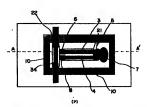
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産 自助事株式会社内

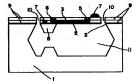
(54) 【発明の名称】 熱型赤外線検知装置

(57) 【要約】

【課題】 感度と応答速度の両立を図るとともにノイズ の影響を受けにくい熱型赤外線検知装置を提供すること。

【解決手段】 基板と、基板上のサーモバイルと、サーモバイルルは接点正時を該基位から熟的に分離する熱分 離城を、サーモバイルの複接点正時に設けられた入け 赤外線吸収領域と、サーモバイルの冷接点近時に設ける れた冷接点温度制御手段と、サーモバイルに発生した熱 起電力を基に冷接点温度制御手段が発生する熱量を削御 する制御手段と含する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、

験基板上のサーモパイルと、

該サーモパイルの温接点近傍を該基板から熱的に分離する熱分離領域と、

該サーモパイルの握接点近傍に設けられた入射赤外線吸収飯域と、

収買率と、 該サーモバイルの冷接点近傍に設けられた冷接点温度制 御手段と、

該サーモバイルに発生した熱起電力を基に冷接点温度制 10 御手段が発生する熱量を制御する制御手段とを有する熱 型赤外線検知装置。

【請求項2】 前配温接点は入射赤外線吸収領域と間の 熱天候が冷接点温度側鉤手段よりも小さく、且つ前配冷 接向の大人試や赤外線吸収領域と間の熱抵抗が冷後点温度 制御手段よりも大きいことを特徴とする請求項1に配載 の熟型赤外線検知装置。

【請求項3】 前配冷接点温度制御手段はジュール熱を 発生することを特徴とする請求項1に記載の熱型赤外線 検知装置。

【請求項4】 前配冷接点温度制御手段はベルチェ効果 を利用したものであることを特徴とする請求項1に記載 の熱型赤外線検知装置。

【請求項5】 前配冷接点近傍も基板と熱分離されていることを特徴とする請求項1に記載の熱型赤外線検知装置。

【発明の詳細な説明】

図4に、平面図を図5に示す。

[0001] 【発明の属する技術分野】本発明はサーモパイルを用いた熱型赤外線維知装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のサーモパイルを用いた熱型赤外線 検知装置には特開昭57-113332号公報に示すよ うかものがある

うなものがある。 【0003】従来の熱型赤外線検知装置の構造斯画図を

【0004】 圏4においてTO-8 などのパッケージ1 01には赤外線活通窓102が設けられている。基板1 03はSiキGeにより形成される。この基板103の 中央部には孔104が設けられ、また、基板103の裏 40 側にはフィルム108があり、この上に物質105,1 06によるサーモンイル107が形成されている。さら に、基板103の表側には黒化膜109がスパック等で 成膜されている。110はリード、111はハーメチッ クシールである。

【0005】関ちにおいて、中央都には重接点、外側に は冷接点が形成されている。また、冷接点の一部分には ダイオードなどからなる感温素子112が形成されてい る。この微温素子112によって周囲温度を計削しその [0006]

【発明が解決しようとする展制 (従来のサーモバイルを 用いた熱型赤外線検知装置において、適距離にある熱顔 の測定を行おうとするとは力信号が非常に散剥であるため に高倍率増幅を行う必要があったが、サーモバイル内 都抵抗が大きいために低ノイズで測定を行うことが困難 であった。

【0007】さらに、サーモパイルでは推検点から流れる熟流を利用しているために熱時定数によって応答速度 が決定されてしまう。従って、感度と応答速度を両立するものをつくることが困難であった。

【0008】従来例では、冷接点の温度を測定してその 結果を補正する方法を採っているが冷接点の温度を積極 的に制御する方法にはなっていなかった。

【0009】本発明は上述のような従来の課題を解消 し、態度と広答速度の両立を図るとともにノイズの影響 を受けにくい熱型赤外線検知装置を提供することを目的 とする。

[0010]

【機題を解決するための手段】本発明は上配課題を解決 するために、基板と、基板上のサーモバイルと、サーモ バイルの温徳点近傍を該基板から熱的に分離する熱分離 領域と、サーモバイルの温接点近傍に設けられた入針等 外線吸収領域と、サーモバイルの冷波点近傍に設けられ た冷波点直度創御手段と、サーモバイルに発生した熱起 電力を基に冷後点温度制御手段が発生する熱量を制御す る削御手段とを有する。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 30 に基づいて具体的に説明する。

【0012】図3は本発明による熱型赤外線検知装置の 実施の形態の構成図である。図3においてp型半導体3 とn型半導体4はA1轉膜で接続されサーモバイル21 を形成している。このサーモバイルの提接点5近傍には 赤外線吸収減g7が形成されている。入射赤外線41に よって加熱された赤外線吸収載g7の熱は主に熱伝導

(熱流 42) によって継接点5〜流れていき提接点5の 個度を上昇させる。冷接点6は初期状態では周囲極度と 同じ遺産に除たれているが、入村療外機 41によって直 接通度が上昇せず率ら複接点5からの熱伝端によって上 昇する。従って進接点5から換点60期には進度差が生 じるためにゼーベッタ効果によって熱気電力が生じる。 この際、熱抵抗と熱容量から計算される熱時定数によっ 知識減点6の施度上昇しつ特点6にまで熱が伝わり熱 短電力が安定するまでには時間透れが生じる。

【0013】 しかし、本実施の影響では、熱風電力によって動作をコントロールされる冷接点温度制御手段 2 と によって冷接点6の温度は温接点5のそれと等しくなる ようにフィードバック制御される。具体的には、アンプ てジュール熱解34の電流両即ら発熱量を制御する。素 外線が入射して選接底50温度が上昇しはじめて熟超度 が供給されが接点5の温度を熱伝導(熱流40)には大量の電流値 が供給されが接点5の温度を熱伝導(熱流40)によっ て上昇させる。この時、サーモバイルを流れる熱流は通 常のサーモバイルとは異なり温接点5及び特接点6のい づれから流れ出るので熱が伝わる長さが約半分となるの で応客性が非常に向上する。

3

【0014】制御回路23の電気的時定数は熱時定数よ りも一桁時以上も小さいので制御回路が律連することは 10 ない。ある時間が経過し、冷接点6と温接点5の温度が 同じになったところで電気的、熱的平衡状態に達する。 このときのジュール熱源34に供給している電流量Iを 電圧値に変化して出力端子33から出力する。電流量1 は入射赤外線強度に依存するので健康量!によって入射 赤外線強度が測定できることになる。この場合、制御回 路23と冷接点6との熟結合、即ち熟抵抗や熱容量など を変化させることで入射赤外線量に対する出力値を変え ることができる。つまり、微小入射赤外線に対して出力 値を大きくできるので後段の信号処理、例えば電圧増幅 20 やA/D変換でS/N比を容易に確保できる。尚、加え て熱時定数が電気的な時定数よりも大きいために信号を 帯域制限した効果もあり、信号の検出が容易になる。 【0015】 (第一の実施の形態) 図1は図3に示した 検知素子の第一の実施の形態を説明する平面図(ア)

10010 (ポーツス施の形態) おれて図るに小し 検知案子の第一の実施の形態を説明する平面図 (ア) と、平面図 (ア) の兼分A-A′で切断した断面図 (イ) である。

【0016】まず、構成から説明する。 関1においてS 1などによる基板1の主平面上にサーモパイル21を支 えるメンプレン2がCVD法などによって形成されてい 30 る。この上にポリシリコンとA1薄膜によって構成され たサーモパイル21がある。p型ポリシリコン3はp 型、n型ポリシリコン4はn型にドープされている。図 中右側のポリシリコンと A 1 薄膜の接続領域が温接点 5、図中左側が冷接点6となる。冷接点6近傍にはジュ ール熱源34を配置する。このジュール熱源34にはポ リシリコン抵抗などが用いられる。この上にはPSGに よる保護膜9及び温接点5近傍には赤外線吸収領域7を 形成する。また、メンプレン2には部分的にエッチング 孔10があけられている。このエッチング孔10を通し 40 てドライエッチングと異方性ウエットエッチングによっ て熱分離領域11を形成している。ただし、冷接点5下 部の基板1は完全には除去されずにヒートシンク8にな っている。このエッチング方法は特別平2-30304 8号公報に詳しく記述されている。

[0017] 次に動作について説明する。入射赤外線は 赤外線吸収傾成でによって吸収され、赤外線吸収傾域7 の温度を上昇させる。この熱は、熱伝導によってサーモ パイル21の温療点5に到達し、温療点5の温度を上昇

って熱分離されているので微小な入射赤外線によって温 度が上昇する。 複接点5と冷接点6との間に温度差が生 じるとゼーベック効果によって熱起電力が発生し二つの 冷接点間に電位差が発生しはじめる。この電位差は制御 回路23に入力され増幅等の信号処理によって冷接点温 度制御手段22に送られ、ジュール熱源34で発生した 熟によって冷接点6を加熱する。この動作は熟起電力が なくなる、即ち複接点5と冷接点6との温度差がなくな るまで続けられて平衡状態に達する。また、サーモパイ ルを両側から加熱することになるので通常のサーモパイ ルよりも高速に行われる。この際、冷接点6近傍の熱時 定数が動作速度を決定することになるが、冷接点温度制 御手段22と冷接点6間の熟抵抗を小さくしておくこと によって改善できる。熱源がなくなった時には、温接点 5への熱の供給がなくなるので温接点5の温度が降下し 始め、冷接点6のほうが温度が高くなるので熱起電力は 逆になる。制御回路23からの信号値は減少し冷接点温 度制御手段22で発生する熱量は減少する。この時の時 定数は冷接点6の熱時定数よりも早くなることはなく、 温接点5の熱時定数で制限されることになり立ち上がり の応答速度よりも遅くなり、通常のサーモパイルとあま り変化はない。

【0018】(第二の実施の形態) 図2は本発明の第二 の実施の形態における検知業子を説明する図である。図 2において(ア)は平面図、(イ)は時面図である。 【0019】第一の実施の形態と異なる部分についての み説明を行う。第一の実施の形態では立ち上がりの応答 適度は向上したが立ち上がりの応答速度には変化がなかった。それは、冷酸点温度制御手吸22が加熱手段しか 持ち合わせていなかったからで、この第二の実施の形態 では加熱一冷却手段をベルチェ素子で実現しようとする ものである。

【0020】まず構成であるが、第一の実施の形態での ポリシリコンヒーターに接えてベルチェ業子を用いてい る。ペルチェ素子の構造はサーモバイルと同じであって 異なる導体や半導体を接続しこれに電流を流すことで接 点の個度を上げたり下げたりするものである。ポリシリ コマーマくることも可能であるが、ZnSe35PP S36などを利用すると効率の良いものができる。

【0021】この第二の実施の形態によれば、立ち上がりには冷禁点ちの温度を上昇させる方向に電流を渡し立ち下がり時には冷禁点もの温度を下降させる方向に電流を洗して速やかに平衡状態にすることができるので応答油度がさらに向上する。

【0022】 従来の素子では冷核点の温度は一定の快まった値として、温核点との肌に生じる温度差をゼーベック効果によって熱起電力に変換して電圧値をそのまま出力値としていたが、本発明では、冷核点近傍に温度削御手段、例えばジュール常派中ペルチェ素子を設けて冷峻

定の値にする。なわち、温接点と冷接点の温度等を限り 無く所定の値に近づくようにコントロールする。この 最、冷接点の温度を制御するのに用いられるエネルギー または常圧などの物理量の値を出力値とする。

[0023]

【発明の効果】本発明のうち代表的なものによって得ら れる効果を簡単に説明すると下記の通りである。

【0024】(1)従来例では熱は温接点から冷接点へ の一方的な流れであったために温接点の熱が冷接点に伝 わるのに時間がかかるために高速動作が期待できなかっ 10 たが、本発明によると熱は温接点及び冷接点のいづれの 方向からも流れてくるので、熱流の流れる距離が約半分 と短くなるために応答速度が向上し、感度との両立が可 能となった。

【0025】(2)従来例では熱起電力そのものを出力 していたために遠距離の物体を検知する際は出力値が非 常に小さくなり加工できる大きさにまで劣化させること なく増幅することが困難であったが、冷接点と退度制御 手段に熟結合(伝導または放射)を適切な値に設定する ことで信号値をあらかじめ大きくすることが可能となる 20 ためにノイズの影響を受けにくくなる。

【0026】(3) 熱結合を主に伝導で行う場合熱時定 数は一般的に電気時定数よりも大きいのでフィルターの 効果を持たせることが可能となり、従来型のような外来 高周波ノイズに悩まされることがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施の形態の検知素子の説明図

【図2】本発明の第二の実施の形態の検知素子の説明図 である。

*30

* 【図3】本発明の熱型赤外線検知装置の動作を説明する 概念図である。

【図4】従来の熱型赤外線検知装置の構造断面図であ వ.

【図5】従来の熱型赤外線検知装置の平面図である。 【符号の説明】

某板

メンブレン 2

3 p型ポリシリコン

4 n型ポリシリコン

退接点

в 冷接点 7 赤外線吸収領域

ヒートシンク

保護隊

エッチング孔 10

11 熱分離領域

21 サーチパイル 22 冷接点温度制御手段

23 制御回路

31 アンプ

製御丁ァ 32

33 出力端子

3 4 ジュール熱源

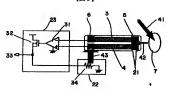
3 5 ZnSe 36 Pbs

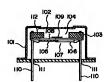
4 1 入射赤外線

42 熟流1

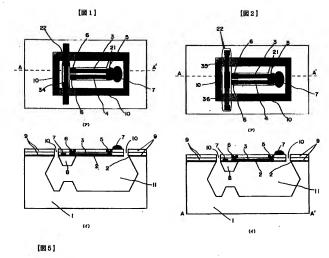
43 熟液2

[図3]





[図4]



105 12 106 106 107 106 107 106 107 106 107 106